

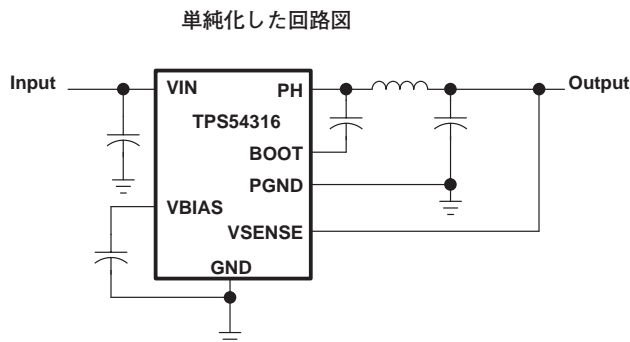
3V-6V入力・3A出力、 FET内蔵の同期バックPWMスイッチャー (SWIFT™)

特長

- 60mΩのMOSFETスイッチによる、3A出力ソース・シンク電流(連続)時の高効率
- 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、および3.3Vの固定出力電圧デバイス 1%初期精度
- 内部補償による使いやすさ、最小の部品点数
- 高速な過渡応答
- 広帯域のPWM周波数：
固定時の周波数 350kHz、550kHz
調整可能な周波数 280kHz-700kHz
- ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンによる負荷保護
- 集積ソリューションによる基板面積およびトータルコストの低減

アプリケーション

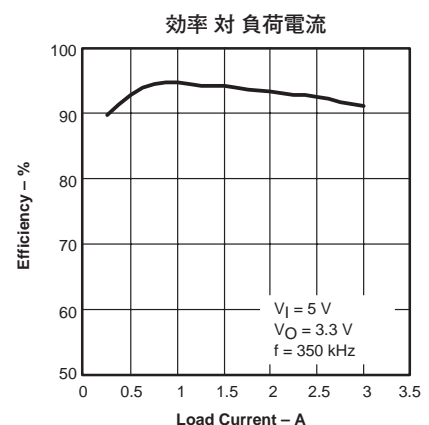
- 5Vあるいは3.3V電源の低電圧・高実装密度システム
- 高性能DSP、FPGA、ASIC、およびマイクロプロセッサの分散電源システム
- 広帯域、ネットワークおよび光コミュニケーションのインフラ
- ポータブル・コンピューティング/ノートブックPC



解説

DC/DCレギュレータのSWIFT™ファミリーであるTPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315、およびTPS54316は、低入力電圧・高出力電流の同期整流降圧PWMコンバータであり、必要な能動素子をすべて集積しています。シリコン基盤上に内蔵されるものは以下の通りです。過渡状態で優れた特性を発揮する高性能誤差アンプ、入力電圧が3Vに達するまでスタート・アップさせない低電圧ロックアウト回路、内部あるいは外部から設定するラッシュ電流制限用のスロー・スタート回路であり、また、プロセッサやロジックのリセット、フォールト信号、および電源シーケンスに有効な高パワー出力です。

TPS54311-16は熱的に強化された20ピンTSSOP (PWP)のPowerPAD™ (パワー・パッド)パッケージによるデバイスのため、大きなヒートシンクを必要としません。TIは、評価ボードとSWIFT™設計者用ソフトウェア・ツールを提供しますので、高性能な電源の設計の早期実現を手助けし、積極的な装置開発サイクルに対応できます。



SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

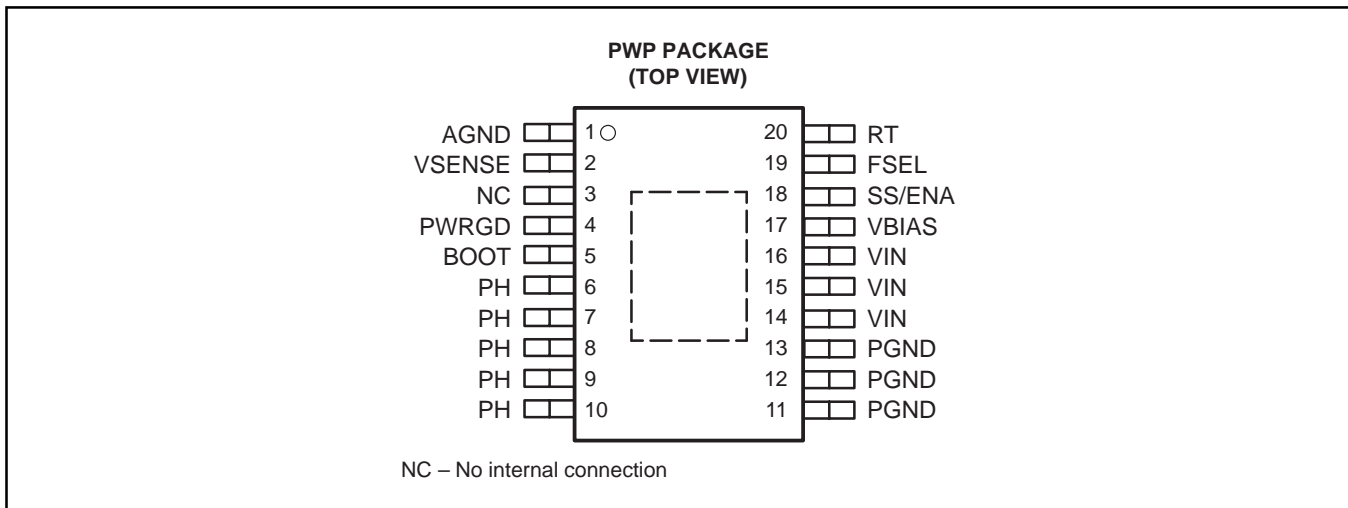
この資料は、Texas Instruments Incorporated (TI) が英文で記述した資料を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス・インスツルメンツ (日本TI) が英文から和文へ翻訳して作成したものです。
資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補助的参考資料としてご使用下さい。
製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料をご確認下さい。
TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわらず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如何なる責任も負いません。



静電気放電対策

静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。

ピン配置



製品オプション

T _J	OUTPUT VOLTAGE	PACKAGED DEVICES PLASTIC HTSSOP (PWP) [†]	T _J	OUTPUT VOLTAGE	PACKAGED DEVICES PLASTIC HTSSOP (PWP) [†]
-40°C~125°C	0.9 V	TPS54311PWP	-40°C~125°C	1.8 V	TPS54314PWP
	1.2 V	TPS54312PWP		2.5 V	TPS54315PWP
	1.5 V	TPS54313PWP		3.3 V	TPS54316PWP

[†] PWPパッケージはテープでリールにしたものもあります。その場合は、Rというサフィックスをデバイスタイプに付加願います(例 TPS54316PWPR)。データシートのアプリケーション・セクションにあるPowerPAD™の機構図とレイアウトを参照願います。

ピンの機能

TERMINAL NAME	TERMINAL NO.	I/O	DESCRIPTION
AGND	1		アナログ・グランド。補償網/出力分圧回路、スロー・スタートコンデンサ、VBIASコンデンサ、RT抵抗およびFSELピンの各帰線になる。PowerPAD™はAGNDに接続する。
BOOT	5		ブートストラップ入力。0.022μFから0.1μFの低等価直列抵抗のコンデンサをBOOTとPH間に接続し、ハイサイドFETドライバをフローティング駆動する。
FSEL	19		周波数選択入力。ロジック・レベルを入力して、2つの内部設定スイッチング周波数から選択する。
NC	3		使用しない(内部の接続なし)。
PGND	11-13		パワー・グランド。ローサイド・ドライバとパワー・MOSFET用の大電流が流れる帰線。大面積の銅パターンのPGNDを入出力電源の帰線、および入出力(VINとVo)コンデンサの負側に接続する。
PH	6-10		フェーズ入出力。内部のハイ・ローサイドの両パワー・MOSFETおよび出力インダクタの結合点。
PWRGD	4		パワー・グッドのオープン・ドレイン出力。VSENSEがVREFの90%以上でハイ・インピーダンス、それ以外ではロー。また、SS/ENAがローあるいは内部シャットダウンがアクティブ時にも、本出力がローになることに注意。
RT	20		周波数設定する抵抗の入力。RTとAGND間に抵抗を接続して、スイッチング周波数を設定する。
SS/ENA	18		スロー・スタートとイネーブルの入出力。デバイス動作をイネーブル・ディスエーブルするロジック入力、および外部的にスタート・アップ時間を設定するコンデンサ入力の2機能のピンである。
VBIAS	17		内部バイアス・レギュレータの出力。内部回路にレギュレーションした電圧を供給。VBIASとAGNDの両ピン間に高品質・低等価直列抵抗の0.1μFから1.0μFのセラミック・コンデンサを接続してバイパスする。
VIN	14-16		パワー・MOSFETスイッチと内部バイアス・レギュレータに供給する入力。VINピンとPGNDピン間で、高品質・低等価直列抵抗の1μFから10μFのセラミック・コンデンサをデバイス・パッケージの極力近くに接続してバイパスする。
VSENSE	2		誤差アンプの反転入力。出力電圧(Vo)の検出点と直結する。

絶対最大定格 (特記ないかぎり仮想接合温度範囲)†

Input voltage range, V _I :	VIN, SS/ENA, FSEL	-0.3 V~7 V
	RT	-0.3 V~6 V
	VSENSE	-0.3 V~4 V
	BOOT	-0.3 V~17 V
Output voltage range, V _O :	VBIAS, PWRGD	-0.3 V~7 V
	PH	-0.6 V~10 V
Source current, I _O :	PH	Internally Limited
	VBIAS	6 mA
Sink current, I _S :	PH	6 A
	SS/ENA, PWRGD	10 mA
Voltage differential :	AGND to PGND	±0.3 V
Continuous power dissipation	See Power Dissipation Rating Table	
Operating virtual junction temperature range, T _J		-40°C~125°C
Storage temperature, T _{stg}		-65°C~150°C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds		300°C

† 絶対最大定格に記述される以上のストレスを加えると、デバイスは永久破壊されることがあります。これらはストレス定格だけであり、これらの条件あるいは推奨動作条件を超える条件でのデバイスのファンクション動作は含まれません。絶対最大定格の条件下に長時間デバイスをさらすと、デバイスの信頼性に影響することがあります。

パッケージ電力消費定格‡

PACKAGE	THERMAL IMPEDANCE JUNCTION-TO-AMBIENT	T _A = 25°C POWER RATING	T _A = 70°C POWER RATING	T _A = 85°C POWER RATING
20-Pin PWP with solder	26.0 mW/°C	3.85 W§	2.12 W	1.54 W
20-Pin PWP without solder	57.5 mW/°C	1.73 W	0.96 W	0.69 W

‡テスト基板条件:

1. 3×3インチ、2層、厚さ0.062インチ
2. プリント基板の部品面に1.5オンスの銅配線
3. プリント基板の半田面に1.5オンスの銅のグラウンド・プレーン
4. 10個のサーマル・ヴィア(本データシートのアプリケーション・セクションにおける推奨ランドパターンを参照願います。)

パッケージのより詳細な情報は、テクニカル・ブリーフ(文献番号SLMA002)を参照願います。

§ 最大電力消費は過電流保護で制限されるかもしれません。

他の3AのSWIFT™デバイス

DEVICE	OUTPUT VOLTAGE
TPS54310	0.9 V~3.3 V

関連DC/DC製品

- UCC3585 — DC/DCコントローラ
- PT5500シリーズ — 3Aプラグイン・モジュール
- TPS757xx — 3A低ドロップアウト・レギュレータ

電気的特性

electrical characteristics, $T_J = -40^\circ\text{C}$ to 125°C , $V_I = 3\text{ V}$ to 6 V (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT	
SUPPLY VOLTAGE, VIN							
Input voltage range at VIN			3.0		6.0	V	
IQ	Quiescent current	Fs = 350 kHz, FSEL ≤ 0.8 V, RT open, Phase pin open		6.2	9.6	mA	
		Fs = 550 kHz, FSEL ≤ 2.5 V, RT open, Phase pin open		8.4	12.8	mA	
		Shutdown, SS/ENA = 0 V		1	1.4	mA	
UNDER VOLTAGE LOCK OUT							
V _{IT(start)}	Start threshold voltage at UVLO			2.95	3.0	V	
V _{IT(stop)}	Stop threshold voltage at UVLO		2.70	2.80		V	
V _{hys}	Hysteresis voltage at UVLO		0.14	0.16		V	
t _f , t _r	Rising and falling edge deglitch at UVLO	See Note 1		2.5		μs	
BIAS VOLTAGE							
Output voltage at VBIAS		I _{VBIAS} = 0	2.70	2.80	2.90	V	
Output current at VBIAS		See Note 2			100	μA	
OUTPUT VOLTAGE							
V _O	Output voltage	TPS54311	T _J = 25°C, VIN = 5.0 V 3 ≤ VIN ≤ 6 V, 0 ≤ I _L ≤ 3 A, -40 ≤ T _J ≤ 125		0.9		V
		TPS54312	T _J = 25°C, VIN = 5.0 V 3 ≤ VIN ≤ 6 V, 0 ≤ I _L ≤ 3 A, -40 ≤ T _J ≤ 125	-2.5%	1.2	2.5%	V
		TPS54313	T _J = 25°C, VIN = 5.0V 3 ≤ VIN ≤ 6 V, 0 ≤ I _L ≤ 3 A, -40 ≤ T _J ≤ 125	-2.5%	1.5	2.5%	V
		TPS54314	T _J = 25°C, VIN = 5.0 V 3 ≤ VIN ≤ 6 V, 0 ≤ I _L ≤ 3 A, -40 ≤ T _J ≤ 125	-3%	1.8	3%	V
		TPS54315	T _J = 25°C, VIN = 5.0V 3 ≤ VIN ≤ 6 V, 0 ≤ I _L ≤ 3 A, -40 ≤ T _J ≤ 125	-3%	2.5	3%	V
		TPS54316	T _J = 25°C, VIN = 5.0V 3 ≤ VIN ≤ 6 V, 0 ≤ I _L ≤ 3 A, -40 ≤ T _J ≤ 125	-3%	3.3	3%	V
		REGULATION					
Line regulation		I _L = 1.5A, 350 ≤ fs ≤ 550 kHz, T _J = 85°C, See Note 1, 3			0.21	%/V	
Load regulation		I _L = 0 to 3A, 350 ≤ fs ≤ 550 kHz, T _J = 85°C, See Notes 1 and 3			0.21	%/A	

- NOTES: 1. 設計保証
 2. 静的な抵抗負荷のみ
 3. 図10の回路でテスト

電気的特性(続き)

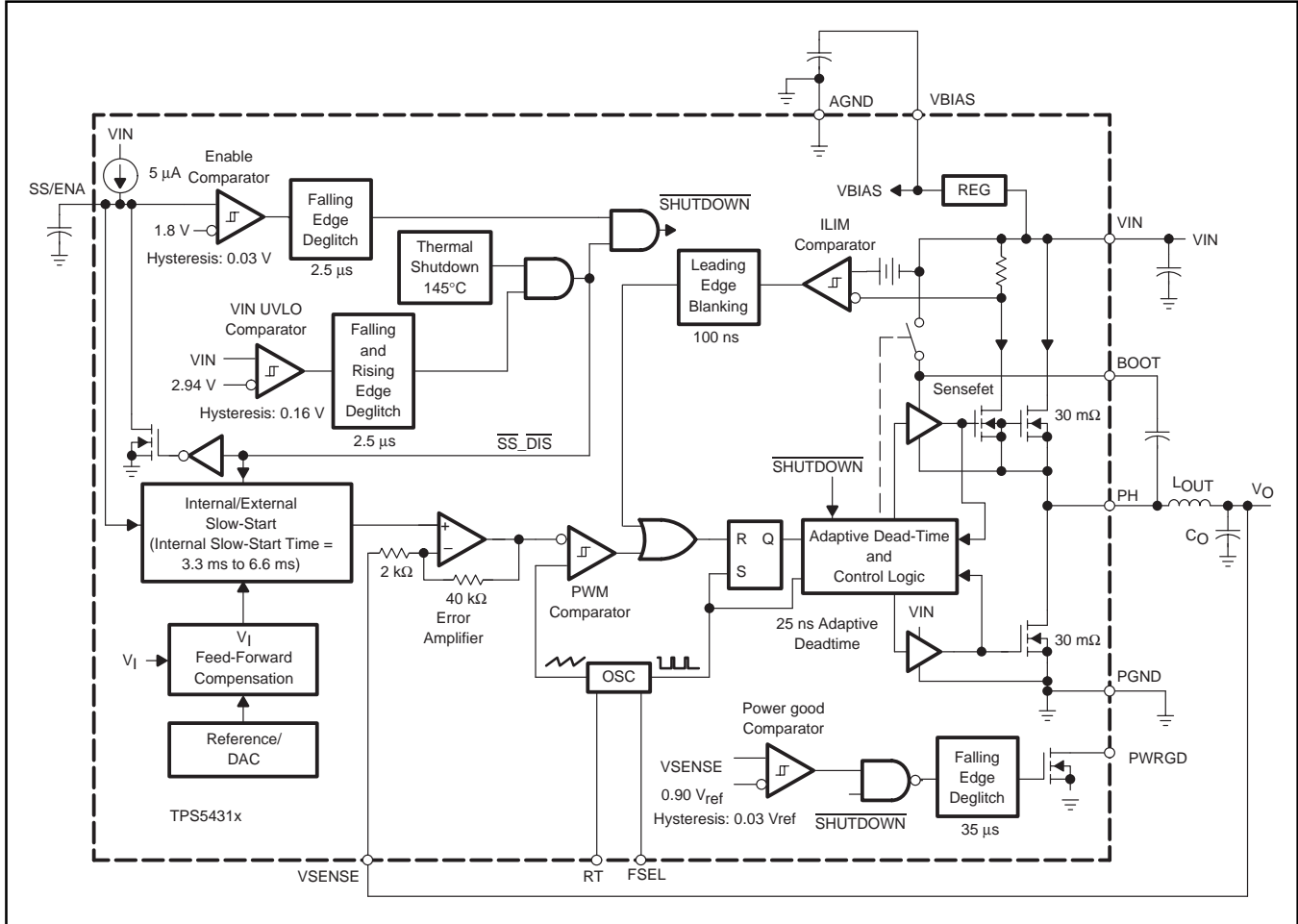
electrical characteristics, $T_J = -40^{\circ}\text{C}$ to 125°C , $V_I = 3\text{ V}$ to 6 V (unless otherwise noted)(continued)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
OSCILLATOR					
Internally set-free running frequency	SYNC $\leq 0.8\text{ V}$, RT open	280	350	420	kHz
	SYNC $> 2.5\text{ V}$, RT open	440	550	660	
Externally set-free running frequency range	RT = 180 k Ω (1% resistor to AGND)	252	280	308	kHz
	RT = 100 k Ω (1% resistor to AGND)	460	500	540	
	RT = 68 k Ω (1% resistor to AGND)	663	700	762	
High level threshold at FSEL		2.5			V
Low level threshold at FSEL				0.8	V
Ramp valley	See Note 1		0.75		V
Ramp amplitude (peak to peak)	See Note 1		1		V
Minimum controllable on time	See Note 1			200	ns
Maximum duty cycle	See Note 1	90%			
ERROR AMPLIFIER					
Error amplifier open loop voltage gain	See Note 1		26		dB
Error amplifier unity gain bandwidth	See Note 1	3	5		MHz
Error amplifier common mode input voltage range	Powered by internal LDO, See Note 1	0		V _{bias}	V
PWM COMPARATOR					
PWM comparator propagation delay time, PWM comparator input to PH pin (excluding dead time)	10 mV overdrive, See Note 1		70	85	ns
SLOW START / ENABLE					
Enable threshold voltage at SS/ENA		0.95	1.20	1.40	V
Enable hysteresis voltage at SS/ENA	See Note 1		0.03		V
Falling edge deglitch at SS/ENA	See Note 1		2.5		μs
Internal slow-start time		2.6	3.35	4.1	ms
Charge current at SS/ENA	SS/ENA = 0V	3	5	8	μA
Discharge current at SS/ENA	SS/ENA = 1.3 V, $V_{IN} = 1.5\text{ V}$	1.5	2.3	4.0	mA
POWER GOOD					
Power good threshold voltage	VSENSE falling		90		%V _{out}
Power good hysteresis voltage	See Note 1		3		%V _{out}
Power good falling edge deglitch	See Note 1		35		μs
Output saturation voltage at PWRGD	I _{sink} = 2.5 mA		0.18	0.30	V
Leakage current, PWRGD	V _{IN} = 5.5 V			1	μA
CURRENT LIMIT					
Current limit	V _{IN} = 3 V (see Note 1)	4.0	6.5		A
	V _{IN} = 6 V (see Note 1)	4.5	7.5		
Current limit leading edge blanking time			100		ns
Current limit total response time			200		ns
THERMAL SHUTDOWN					
Thermal shutdown trip point	See Note 1	135	150	165	$^{\circ}\text{C}$
Thermal shutdown hysteresis	See Note 1		10		$^{\circ}\text{C}$
OUTPUT POWER MOSFETS					
Small signal drain-source on power MOSFET switches R _{DS-ON}	I _O = 3A, V _{IN} = 6.0 V See Note 4		59	88	m Ω
	I _O = 3A, V _{IN} = 3.0 V See Note 4		85	136	

NOTES: 3. 図10の回路でテスト

4. 整合のとれたMOSFETであり、ローサイドのはテストされ、ハイサイドのは設計保証

機能ブロック図



詳細解説

低電圧ロックアウト (UVLO)

低電圧ロックアウト回路は、入力電圧 (VIN) が不十分な時にデバイスをディスエーブルに保ちます。電源投入中は、VIN が UVLO のスレッショールド電圧 (公称値 2.95V) を超えるまで、内部回路を停止状態に維持します。ひとたび VIN が UVLO スタートのスレッショールド電圧に達すると、デバイスはスタート・アップを始めます。デバイスは、VIN が UVLO ストップのスレッショールド電圧 (公称値 2.8V) を下回るまで動作します。このような UVLO コンパレータのヒステリシスと、2.5µs の立ち上がり・立ち下がりエッジのデグリッチ回路が、VIN に乗った雑音によるデバイスのシャットダウンの可能性を低減します。

スロー・スタート/イネーブル (SS/ENA)

スロー・スタート/イネーブルのピンには2つの機能があります。第一は、イネーブル(シャットダウン)制御としての働きであり、ここの電圧がスタート・スレッショールド電圧 (約 1.2V) を超えるまでデバイスを停止状態に保ちます。SS/ENA がスタート・スレッショールド電圧を超えると、デバイスはスタート・アップを開始します。このとき、誤差アンプに供給される基準電圧は、0V から 0.891V まで 3.35ms で直線的に上昇します。同様に、デバイスの出力電圧もレギュレーションのレベルに約 3.35ms で到達します。このようなヒステリシス電圧と 2.5µs の立ち下が

りエッジのデグリッチ回路が、雑音による誤ったイネーブルのトリガーの可能性を低減します。

SS/ENAピンの第二の機能は、このピンとAGND間に小容量コンデンサを接続して、外部からスロー・スタート時間を拡張する手段を与えることです。SS/ENAピンにコンデンサを付けると、スタート・アップに関する2つの効果があります。まず、SS/ENAピンのリリースと出力のスタート・アップ間に遅延が生じます。この遅延はスロー・スタート用コンデンサの値に比例し、SS/ENAピンの電位がイネーブル・スレッショールド電圧に達するまで続きます。このスタート・アップ遅延は、およそ式(1)のようになります。

$$t_d = C(SS) \times \left(\frac{1.2V}{5\mu A} \right) \quad (1)$$

次に、出力がアクティブになると、外部設定のスロー・スタート時間が効く前に、内部設定スロー・スタート時間のわずかな上昇が観察されます。それから、出力はスロー・スタート用コンデンサの容量値に比例して上昇します。コンデンサにより外部設定されるスロー・スタート時間は、およそ式(2)のようになります。

$$t(SS) = C(SS) \times \left(\frac{0.7V}{5\mu A} \right) \quad (2)$$

実際のスロー・スタート時間は、内部設定の時間が若干短くなるため、上式の近似より短くなるかもしれません。

VBIASレギュレータ (VBIAS)

VBIASレギュレータは、内部アナログ・デジタルの両ブロックに、接合温度と入力電圧の変動に依存しない安定した電源を供給します。VBIASピンには、高品質かつ低等価直列抵抗のセラミックのバイパス・コンデンサが必要です。温度変動に対して安定なX7RあるいはX5Rクラスの誘電体を推奨します。バイパス・コンデンサは極力VBIASピンの近くに配置し、AGNDに接地します。VBIASに外部の負荷をつけることは可能ですが、内部回路が最小2.70VのVBIASを必要とすること、VBIASに接続した外部負荷によるACあるいはデジタル雑音特性を劣化させることに注意を要します。VBIASピンは外部回路の基準電圧として使うこともできます。

基準電圧

基準電圧システムは、高精度で温度に対して安定な電圧をバンドギャップ回路から作ります。スケーリング・アンプとDACを用い、各デバイスの固有出力の基準電圧を発生します。

発振器とPWMランプ

発振周波数は、FSELピンに静的なデジタル入力を印加して、内部的に350kHzあるいは550kHzの固定値に設定できます。アプリケーションによって異なる動作周波数が必要ならば、RTピンとAGND間に抵抗を接続し、かつFSELピンをオープンにして、発振周波数を外部的に280kHzから700kHzまで調整できます。スイッチング周波数は式(3)で近似されます。ここで、RはRTとAGND間の抵抗値です。

$$\text{スイッチング周波数} = \left(\frac{100 \text{ k}\Omega}{RT} \right) \times 500 \text{ kHz} \quad (3)$$

下表に周波数選択の組み合わせを要約します。

SWITCHING FREQUENCY	SYNC PIN	RT PIN
350 kHz, internally set	Float or AGND	Float
550 kHz, internally set	≥ 2.5 V	Float
Externally set 280 kHz to 700 kHz	Float	R = 180 k to 68 k

誤差アンプ

高性能で広帯域の誤差アンプは、制御ループの内部補償をするために利得が限定されています。これによって、ユーザーの出力LCフィルタ用部品の選択も限定されます。4.7μHから10μHのインダクタンスが一般的な値であり、数社から入手できます。このように設計すると、非常に優れた過渡応答とともに、良好な雑音およびリップル特性を示します。過渡回復時間は一般に10から20μsの範囲です。

PWM制御

誤差アンプ、発信器、および電流制限回路の各出力信号はPWM制御ロジック回路で処理されます。内部ブロック図を参照すると、制御ロジック回路にはPWMコンパレータ、ORゲート、PWMラッチ、およびデッドタイムと制御ロジック・ブロックの一部があります。電流制限のスレッシュホールド電圧より低い安定動作では、PWMコンパレータ出力と発振器パルスが交互にPWMラッチをリセットおよびセットします。PWMラッチがリセットされると、ローサイドFETが発振器パルス幅による最小期間だけ

オンします。この間、PWMのランプ波形は谷の電圧値まで急速に放電します。次にランプ波形が充電を始めると、ローサイドFETはオフし、ハイサイドFETがオンします。PWMランプ波形が誤差アンプの出力電圧を超えると、PWMコンパレータがラッチをリセットし、その結果ハイサイドFETがオフし、ローサイドFETがオンします。そしてローサイドFETは、次の発振器パルスがPWMランプ波形を放電するまでオンを続けます。

過渡状態では、誤差アンプ出力がPWMランプ波形の谷電圧以下やピーク電圧以上になるかもしれません。誤差アンプ出力が高い場合、PWMラッチはリセットされず、発振器パルスが制御ロジックにハイサイドFETのオフとローサイドFETのオンの信号を出すまで、ハイサイドFETはオンを維持します。このとき、出力電圧がレギュレーションの設定値に達するまで、デバイスはVSENSEにほぼに等しい電圧を供給しながら最大デューティで動作します。誤差アンプ出力が低い場合、PWMラッチは継続的にリセットされ、ハイサイドFETはオンしません。このときローサイドFETは、VSENSEの電圧が低下してPWMコンパレータの状態を反転させるまでオンし続けます。TPS54311-16は、出力がレギュレーションの設定値に達するまで連続的に電流をシンクできます。

電流制限コンパレータが100ns以上動作すると、PWMランプ波形が誤差アンプ出力を超える前にPWMラッチをリセットします。そして、ハイサイドFETはオフし、ローサイドFETはオンして、出力のインダクタのエネルギーを低減し、出力電流を減少します。この過程は、電流制限コンパレータが動作するサイクルごとに行われます。

デッドタイム制御とMOSFETドライバ

適応性の高いデッドタイム制御は、MOSFETドライバのターン・オン時間を積極的に制御して、両方のNチャネル・パワーMOSFETにおける貫通電流を防止します。ハイサイド・ドライバは、ローサイドFETのゲート電圧が2V以下になるまでオンしません。また、ローサイド・ドライバは、ハイサイドMOSFETのゲート電圧が2V以下になるまでオンしません。ハイサイドとローサイドの両ドライバは300mAのソースおよびシンク能力で設計され、パワーMOSFETのゲートを急速にドライブできます。ローサイド・ドライバはVINから電源を供給され、ハイサイド・ドライバはBOOTピンから電源を供給されています。そのブートストラップ回路は、外付けのBOOTコンデンサと、VINピンとBOOTピン間の内部に2.5Ωのブートストラップ・スイッチを用いています。このブートストラップ・スイッチはドライブ効率を高め、外付けの部品点数を節約します。

過電流保護

電流制限はサイクルごとになされ、ハイサイドMOSFETを流れる電流を検知し、これをプリセットの過電流スレッシュホールド電圧と比較します。ハイサイドMOSFETは、電流制限スレッシュホールド電圧に達して200ns以内にオフします。立ち上がりエッジを100nsだけブランピングする回路が、電流制限の誤作動を防止します。電流制限の検出は、VINからPHへ流れる電流が出力フィルタに供給される場合のみに行われます。電流をシンクする場合の過負荷保護は、サーマル・シャットダウンで行われます。

サーマル・シャットダウン

デバイスの接合温度が150°Cを超えると、デバイスはサーマル・シャットダウンを用いてパワーMOSFETをオフし、制御回路をディスエーブルにします。接合温度がサーマル・シャットダウンの動作点より10°C低下すると、デバイスはシャットダウン状態から解放され、スロー・スタート回路の制御下でスタート・アップします。サーマル・シャットダウンは過負荷状態が数mS続くと作動します。不良状態が持続すると、デバイスは次のサイクルを繰り返します。すなわち、ソフト・スタート回路の制御下でのスタート・アップ、不良状態による温度上昇、そしてサーマル・シャットダウン温度に達してのシャットダウンというサイクルです。

パワー・グッド(PWRGD)

パワー・グッド回路はVSENSEにおける低電圧状態を監視します。VSENSEの電圧が基準電圧より10%下回ると、オープン・ドレインのPWRGD出力がローになります。また、VINがUVLOスレッシュホールド電圧を下回る、あるいはSS/ENAが低い、さらにサーマル・シャットダウンが作動した場合にもPWRGD出力がローになります。VIN = UVLOスレッシュホールド電圧、SS/ENA = イネーブル・スレッシュホールド電圧、およびVSENSE > ×90%の各場合は、オープン・ドレインのPWRGD出力がハイになります。V_{ref}の3%に相当するヒステリシス電圧と35µsの立ち下がりエッジのデグリッチ回路が、高周波雑音によるパワー・グッド・コンパレータの誤作動を防止します。

代表的特性

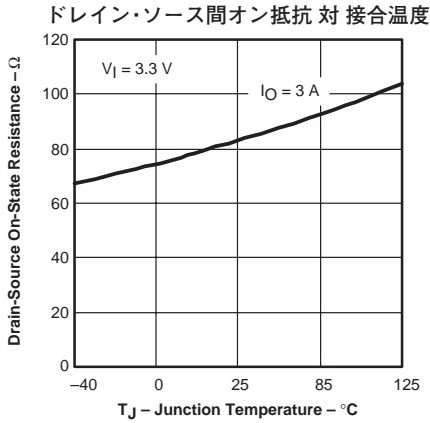


Figure1

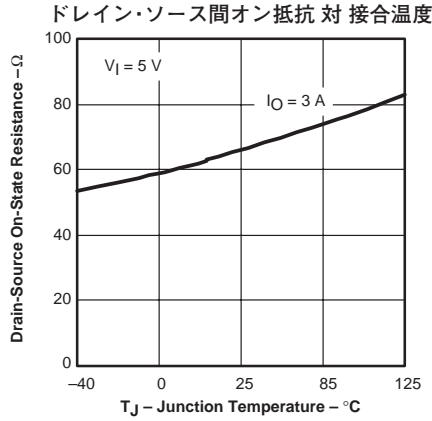


Figure2

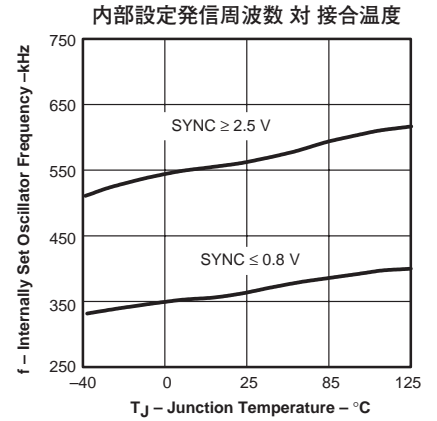


Figure3

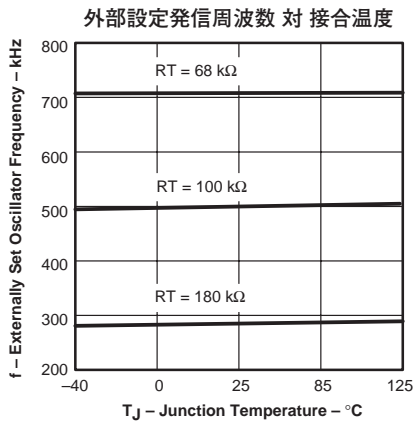


Figure4

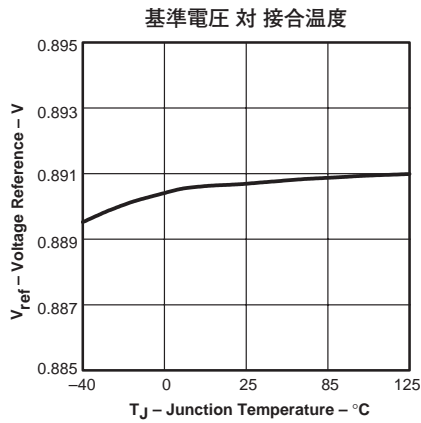


Figure5

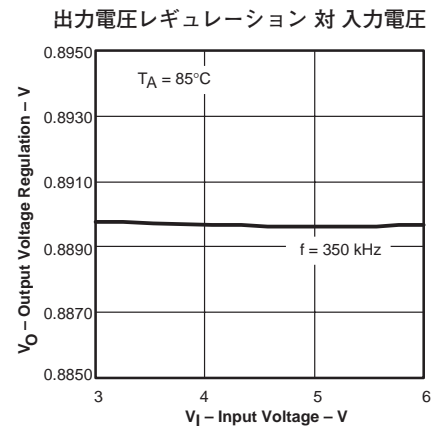


Figure6

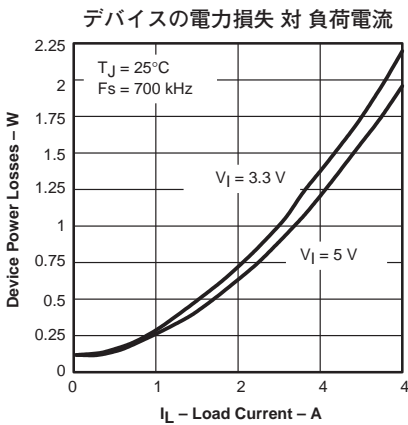


Figure7

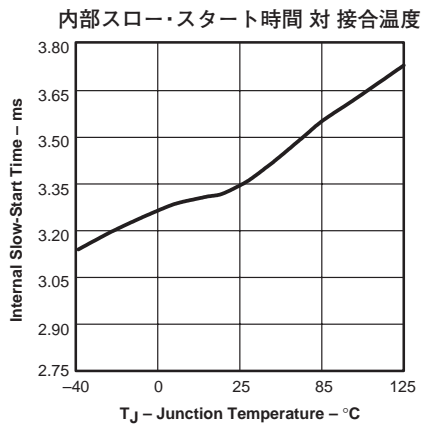


Figure8

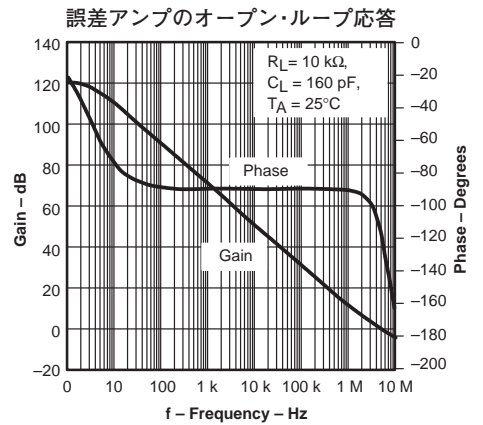


Figure9

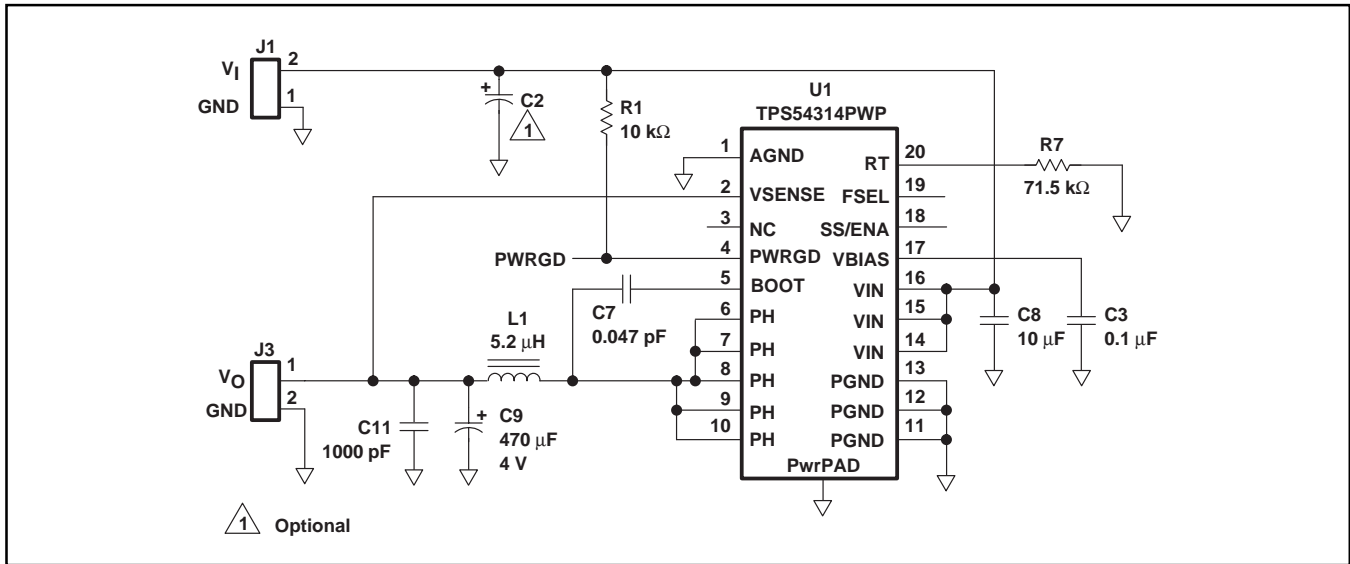


Figure10. TPS54314の回路図

アプリケーション情報

Figure10はTPS54314の代表的なアプリケーション回路図を示します。TPS54314(図中のU1)は、公称値1.8Vの出力電圧で3Aまでの出力電流を供給できます。適切な熱特性を得るために、TPS54310の直下のPowerPAD™をプリント基板に十分に半田付けする必要があります。

入力電圧

回路への入力電圧は5VDC(公称値)であり、J1に供給します。オプションの入力フィルタ(C2)は220μFのPOSCAP(チップ型のタンタル電解コンデンサ)コンデンサであり、最大許容リップル電流が3Aのものです。C8はTPS54314のデカップリング・コンデンサであり、デバイスにできるだけ接近させて取り付けます。

帰還回路

コンバータの出力電圧をTPS54314のVSENSEピンに直接入力します。TPS54314は内部補償により、ラインおよび負荷条件の変動に対して安定な出力を供給します。

動作周波数

本アプリケーション回路では、FSELをオープンにし、71.5kΩの抵抗をRTとAGND間に接続して700kHzの動作周波数を選択しています。これと異なる周波数は、R7の値を式(4)にしたがって変更して設定できます。

$$R = \frac{500 \text{ kHz}}{\text{Switching Frequency}} \times 100 \text{ k}\Omega \quad (4)$$

また、動作周波数を350kHzあるいは550kHzに設定するには、RTをオープンにし、FSELピンをそれぞれAGNDあるいはVINに接続します。

出力フィルタ

出力フィルタは5.2μHのインダクタと470μFのコンデンサで構成されます。このインダクタは低DC抵抗(16mΩ)タイプのスミダ製CDRH104R-5R2です。コンデンサは4VのPOSCAPで、最大等価直列抵抗が40mΩのものを使用しています。出力フィルタ部品は内部補償回路網とともに、コンバータの閉ループ応答を安定なものにしています。

グラウンドのとりかたとパワー・パッドのレイアウト

TPS54311-16にはアナログとパワーの2つの内部グラウンドがあります。TPS54311-16の内部では、アナログ・グラウンドをすべての雑音に敏感な信号に接続し、パワー・グラウンドは雑音を発生するパワー信号に接続しています。PowerPAD™は直接AGNDに接続する必要があります。両グラウンド間に入った雑音はTPS54311-16の特性を劣化させ、特に大出力電流時に顕著になり得ます。しかし、アナログ・グラウンド・プレーンの雑音は、制御信号やバイアス信号に問題を発生します。したがって、これらの理由から、アナログとパワーの両グラウンド・プレーンを分離することを推奨します。この両プレーンはICにおいて互いに接続し、両グラウンド間の雑音を低減します。直接にパワー・グラウンド・プレーンに接続する部品は、入力コンデンサ、出力コンデンサ、入力電圧デカップリング用コンデンサ、およびTPS54311-16のPGNDピンだけです。TPS54314用評価モジュールのレイアウトは、4層基板の推奨レイアウトの代表例です。TPS54314用評価モジュールの文献は、TIのウェブサイトのTPS54314製品フォルダ、およびアプリケーション・ノートのTI文献番号SLVA111にあります。

熱特性に関するレイアウトの考察

最大負荷電流での動作のため、アナログ・グランド・プレーンには適当な放熱領域が必要です。それには、1オンスの銅による3インチ×3インチのプレーンを推奨します。これは必須というわけではなく、周囲温度と空気流に依存します。ほとんどのアプリケーションには内部グランド・プレーンの広い領域があり、パワー・パッドはその中で最大面積のものに接続します。部品面や半田面にある他の領域も放熱に寄与するので、3A以上の動作時はすべての領域を放熱に使用します。パワー・パッドの露出領域と

アナログ・グランド・プレーン層との接続には、直径0.013インチのビアを用いて、ビアによる半田の上がりを取り除きます。パワー・パッド領域に6個のビアを作り、さらにデバイス・パッケージの直下に4個のビアを作ります。このパッケージ直下のビアのサイズは、露出したサーマル・パッド領域とは違って、0.018インチまで拡張できます。推奨するこれら10個のビアに加えて、熱特性を強化するビアをデバイス・パッケージの下以外の領域にも作ります。

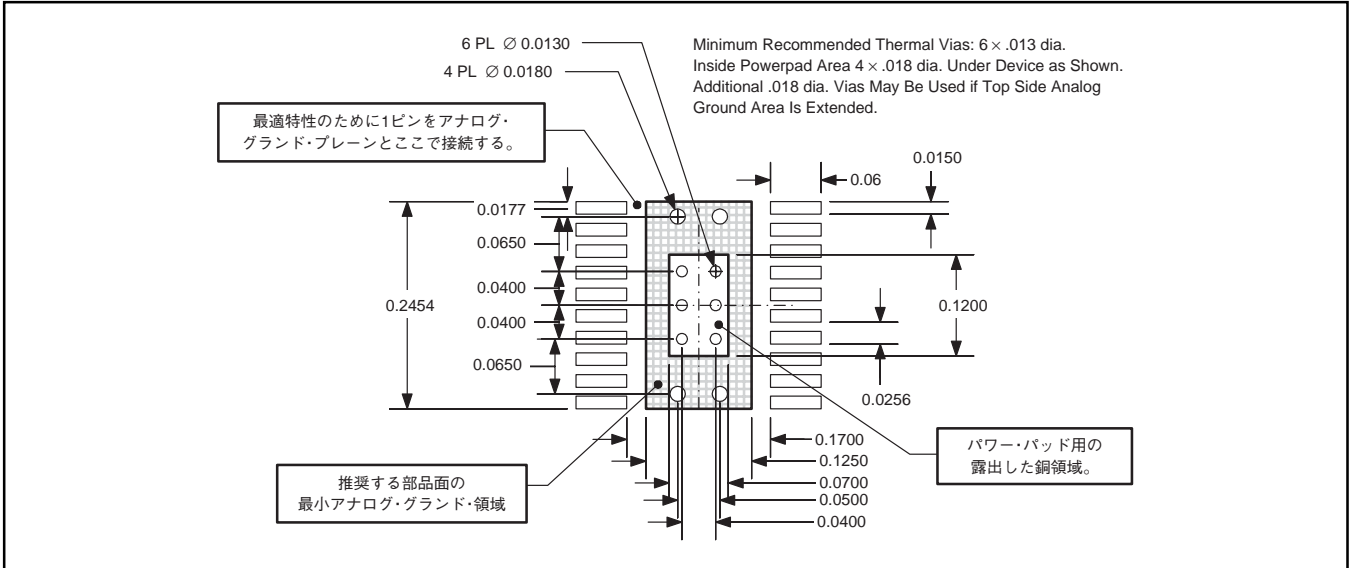


Figure 11. 20ピンPWP PowerPAD™用の推奨ランド・パターン

特性グラフ

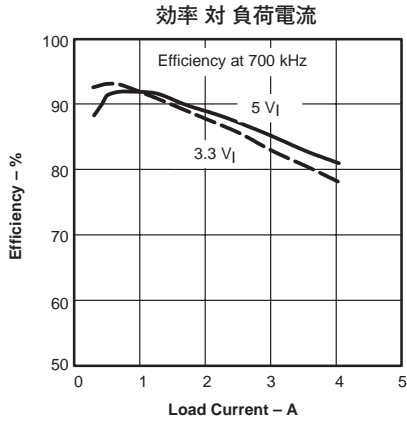


Figure12

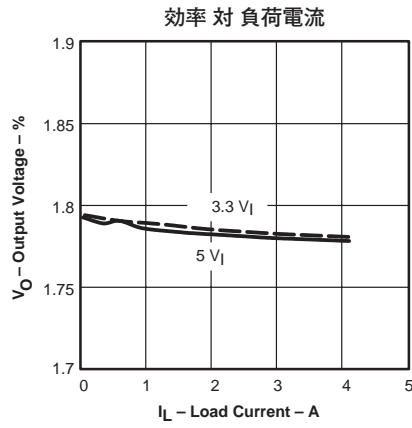


Figure13

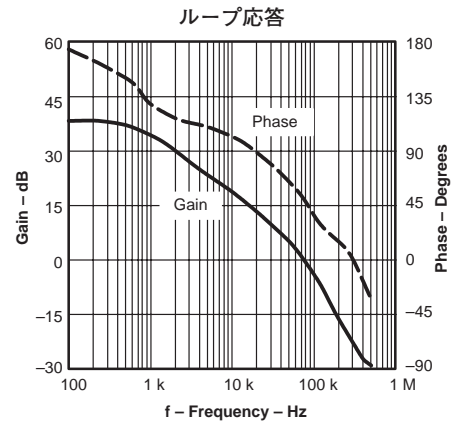


Figure14

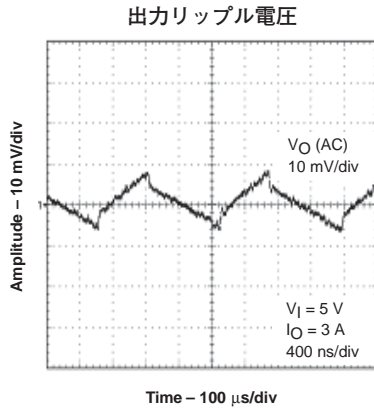


Figure15

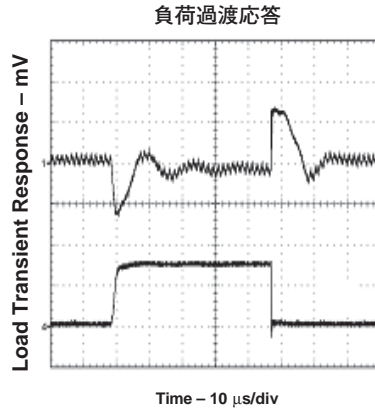


Figure16

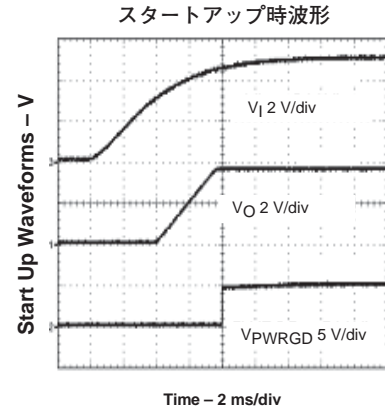


Figure17

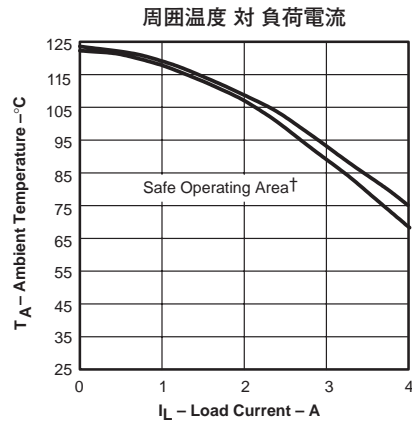


Figure18

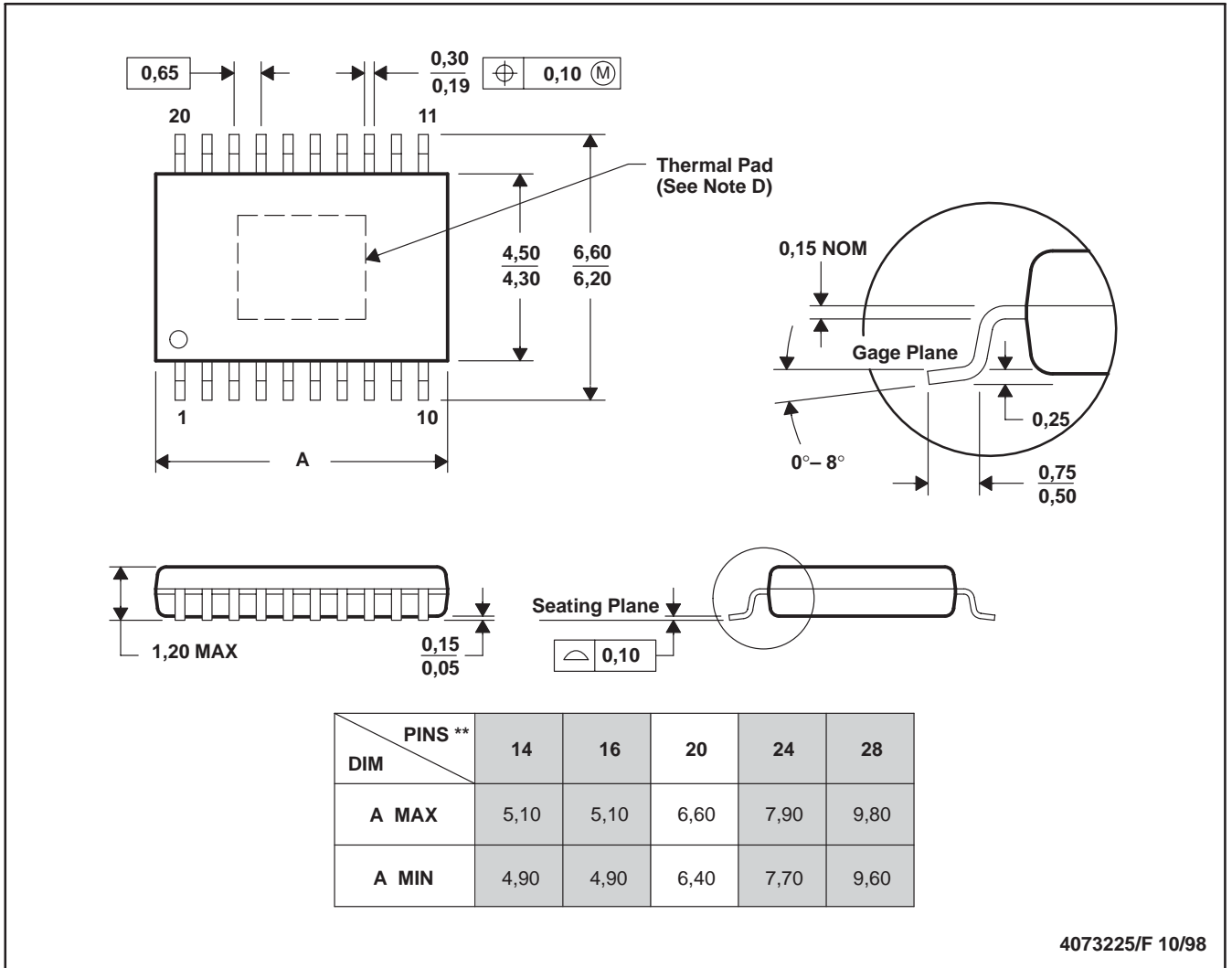
†安全動作領域は、本データシートのパッケージ電力消費定格表に記述されたテスト基板条件に適用されます。

外観

PWP (R-PDSO-G**)

PowerPAD™ PLASTIC SMALL-OUTLINE

20 PINS SHOWN



4073225/F 10/98

- 注：A. 直線的な寸法はすべてミリメートルです。
 B. 本図は通達なしに変更することがあります。
 C. 本体の寸法はモールド・フラッシュや突起を含みません。
 D. パッケージの熱特性は、サーマル・パッドを外部プレーンにボンディングすると強化されます。このパッドは電気的かつ熱的にチップの背面と結合します。また、できるかぎり一部のリードとも接続させます。
 E. JEDEC MO-153の規格に準拠します。

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社(以下TIJといたします)及びTexas Instruments Incorporated(TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIJといたします)は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIJは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメータに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIJは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIJは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしていません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは承認をすることを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIJにより示された数値、特性、条件その他のパラメータと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIJは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIJは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション(例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの)に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIJがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。

弊社出荷梱包単位(外装から取り出された内装及び個装)又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で(導電性マットにアースをとったもの等)、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。

マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。

前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

温度: 0~40、相対湿度: 40~85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。(但し、結露しないこと。)

直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

3. 防湿梱包

防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

4. 機械的衝撃

梱包品(外装、内装、個装)及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

5. 熱衝撃

はんだ付け時は、最低限260以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。(個別推奨条件がある時はそれに従うこと。)

6. 汚染

はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質(硫黄、塩素等ハロゲン)のある環境で保管・輸送しないこと。はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。(不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。)

以上